

## 性能及び試験方法

### ■性能及び試験方法

項目		性能	試験方法および条件 (JIS C 5101-1準拠)				
		X7R 特性					
静電容量		許容差以内	<table border="1"> <tr> <td>測定周波数</td> <td>測定電圧</td> </tr> <tr> <td>1kHz±10%</td> <td>1.0V±10%</td> </tr> </table>	測定周波数	測定電圧	1kHz±10%	1.0V±10%
測定周波数	測定電圧						
1kHz±10%	1.0V±10%						
誘電正接		2.5%以下	測定前に熱処理を行う				
耐電圧		絶縁破壊および破損のないこと	印加電圧 : 1~5秒間 シリコンオイル中で印加 充放電電流 : 50mA以下 印加電圧 : 定格電圧×250%				
絶縁抵抗		10,000MΩ以上	印加電圧 : 定格電圧 印加時間 : 1分間				
固着性	ワイヤーボンディング	0.03N以上	Φ25μのAuワイヤーにてボンディング実装を行った後ワイヤーを引っ張り強度を測定する				
温度 サイクル	外観	著しい機械的損傷がないこと	常温→最低使用温度→常温→最高使用温度 3分 → 30分 → 3分 → 30分 上記1~4段階の温度に順次放置し1サイクルとする この操作を25サイクル繰り返す				
	静電容量変化率	±7.5%以下					
	Qおよび誘電正接	初期値を満足すること					
	絶縁抵抗	初期値を満足すること					
	耐電圧	絶縁破壊および破損のないこと					
耐湿負荷	外観	著しい機械的損傷がないこと	試験前に電圧処理を行う。 試験温度: 85±2°C 相対湿度: 85±3%RH 試験電圧: 3.0 試験時間: 240-0,+24時間				
	静電容量変化率	±12.5%以下					
	Qおよび誘電正接	初期値の2倍以下					
	絶縁抵抗	1,000MΩ以上					
高温負荷	外観	著しい機械的損傷がないこと	試験前に電圧処理を行う。 試験温度: 125±3°C 試験電圧: 定格電圧 試験時間: 2000-0,+48時間				
	静電容量変化率	±12.5%以下					
	Qおよび誘電正接	初期値の2倍以下					
	絶縁抵抗	1,000MΩ以上					

注1: 熱処理は150+0/-10°Cにて1時間後、室温中に取り出し48±4時間放置する

注2: 電圧処理は試験条件に規定されている条件にて1時間処理後、室温中に取り出し48±4時間放置する